

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2001-520446 (P2001-520446A)

【公表日】平成 13 年 10 月 30 日 (2001.10.30)

【出願番号】特願 2000-516391 (P2000-516391)

【国際特許分類】

**H 0 1 M 4/88 (2006.01)**

**C 2 5 B 11/04 (2006.01)**

**G 0 1 N 27/28 (2006.01)**

**H 0 1 M 4/86 (2006.01)**

**H 0 1 M 8/10 (2006.01)**

**C 2 5 B 9/00 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 M 4/88 C

C 2 5 B 11/04 A

G 0 1 N 27/28 Z

G 0 1 N 27/28 3 3 1 D

H 0 1 M 4/86 H

H 0 1 M 8/10

C 2 5 B 9/00 E

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 6 月 27 日 (2005.6.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 a) 多孔質膜にイオン伝導性電解質を部分的に充填して部分充填膜を作製する工程と；

b) 前記部分充填膜から空隙体積をなくし、電極粒子を前記部分充填膜に埋め込むように前記部分充填膜と前記電極粒子を互いに圧縮する工程とを含む膜電極アセンブリの作製方法。

【請求項 2】 前記電極粒子がナノ構造要素である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、a) 多孔質膜をイオン伝導性電解質の溶液に浸漬し、次に b) 前記膜を乾燥することを含む少なくとも 1 つの浸漬工程を含む請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 4】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、多孔質膜とイオン伝導性電解質の溶液とを互いに機械的に圧縮することを含む請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 5】 前記多孔質膜を部分的に充填する前記工程が、空気圧差によってイオン伝導性電解質の溶液を多孔質膜に強制的に送り込むことを含む請求項 1 又は 2 に記載の方法。